

การสังเคราะห์วงจรขยายในโหมดกระแสด้วย VDTA ตัวเดียวที่ต่อใช้งานด้วย LM13700 A Synthesis Current-mode Amplifier Employing Single VDTA Implementation with LM13700

ชิติสรรค์ วิชิโต¹ วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์² พุทธาวดี สีกุลธร³ และสมชาย ศรีสกุลเตี้ย⁴

Chitisan Wichito¹ Wudthipong Pichiwong² Puttawud Leekruntorn³ Somchai Srisakultiew⁴

^{1, 2, 3, 4}วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นครราชสีมา

E-mail: somchaikorat2008@hotmail.com

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอการสังเคราะห์วงจรขยายในโหมดกระแสด้วย VDTA เพียงตัวเดียว สามารถต่อใช้งานจริงได้ด้วยไอซี LM13700 ที่มีลักษณะเด่นคือใช้อุปกรณ์แยกไฟฟ้า VDTA เพียงตัวเดียวปราศจากอุปกรณ์พารามิเตอร์ สามารถปรับอัตราขยายได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลการทำงานกับอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ $27-100^{\circ}\text{C}$ จำลองการทำงานด้วยโปรแกรม PSpice พบว่าจะสามารถทำงานได้สอดคล้องตามที่คาดการณ์ไว้ ในทฤษฎี จากการต่อใช้งานจริงด้วยไอซีสามารถทำงานได้จริงเป็นไปตามทฤษฎี และผลการจำลอง ทั้งนี้มีผลตอบสนองทางความถี่มากกว่า 1 MHz มีอัตราการสั่นเปลืองพลังงานเมื่อทำการจำลองการทำงานเท่ากับ 0.58 mW. ที่แหล่งจ่าย 1.5 โวลต์ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานในด้านการสื่อสารข้อมูลได้ดีด้วย คำสำคัญ วงจรขยาย โหมดกระแส วงจรขยายความนำ ผลกระทบต่างแรงดันไอซี LM13700

Abstract

This article describes a synthesis current-mode amplifier employing single VDTA (Voltage differencing Transconductance Amplifier). It can be implemented with LM13700. Their features are that: it's consist of VDTA only without any passive elements, electronically controllable, non-effect in low temperature at $27-100^{\circ}\text{C}$. The simulation result obtained from PSpice are accordance with the theoretical predictions.

From the actual used from IC can actually work to the theory and simulation results. The proposed circuits have frequency responds of more than 1MHz, power consumption 0.58mW at 1.5V supply voltage. It can be application to the data communication.

Keywords: Amplifier, Current-mode, VDTA, LM13700

1. บทนำ

วงจรขยายกระแสเดี่ยวกันนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบที่ต้องการใช้กำลังไฟฟ้าและแหล่งจ่ายไฟต่ำ เช่น ระบบสื่อสารเครื่องมือวัด เป็นต้น [1-2] ทั้งนี้ตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะลดแรงดันไฟเหลือง ในวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องมาจากความต้องการ ที่จะนำมาใช้กับอุปกรณ์แบบพกพา หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย ที่ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายกำลังงาน ดังนั้นจึงมีการใช้เทคนิคการทำงานในโหมดกระแส (Current-mode) ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เมื่อเทียบกับเทคนิคการทำงานในโหมดแรงดัน เช่น มีช่วงพิสัยพลังวัตถิกว้าง (Larger dynamic range) มีแบบดิจิทิกว้าง และบริโภคกำลังงานต่ำ [3-4]

สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถนำมาออกแบบและสร้างเป็นวงจรขยายกระแสเดี่ยวนั้น ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด หนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้นที่ได้รับความนิยมคือวงจรขยายความนำถ่ายโอน (Operational transconductance amplifier: OTA) เนื่องจากในปัจจุบันได้ถูกผลิตออกมาจำนวนมากเป็นวงจรรวมหรือไอซี

อย่างแพร่หลาย เช่น เบอร์ CA3800, LT1228, LM13600 เป็นต้น โดยวงจรขยายความนำถ่ายโอนเป็นอุปกรณ์แยกทีฟ (Active element) ที่เหมาะสมในการนำไปออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณและลอก [5] ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น สามารถควบคุมอัตราขยายทางด้านเอาต์พุตได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [6] มีแบนด์วิชกว้างเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ปัจจุบัน [7] เป็นต้น ไอซี LM13700 [8] วงจรภายในเสมือนมีวงจรขยายความนำถ่ายโอน จำนวนสองตัวอยู่ภายใต้ความสามารถต่อใช้งานจริงได้

นอกจากวงจรขยายความนำถ่ายโอนแล้ว ยังมีอุปกรณ์แยกทีฟอีกชนิดอื่น ๆ ที่สามารถออกแบบให้เป็นวงจรขยายกระแสได้ เช่น CCI[9], CCCII[10], CFA[11], CDTA[12], CCTA[13] ต่างก็สามารถออกแบบให้เป็นวงจรขยายกระแสได้เช่นกัน แต่ก็ยังมีข้อด้อยของวงจรดังต่อไปนี้คือ

- ใช้อุปกรณ์แยกทีฟ เป็นจำนวนมาก [9, 10, 11, 12, 13]
- ต้องต่อร่วมกับอุปกรณ์พัลซีส [9, 10, 11, 12, 13]
- ไม่สามารถปรับอัตราขยายได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [9]

วงจรขยายความนำถ่ายผลต่างแรงดัน (Voltage Differencing Transconductance Amplifier: VDTA) เป็นอุปกรณ์แยกทีฟที่มีการนำเสนอมามาก่อน [14] มีลักษณะเด่นของตัวอุปกรณ์คือ ความแตกต่างของแรงดันที่ขาอินพุต (V_{VP} , V_{VN}) จะส่งผ่านกระแสที่ขา Z โดยอัตราการส่งผ่านความนำกระแสเดียวกับความนำกระแสตัวแรก และแรงดันต่อกคร่อมที่ Z ยังทำให้ส่งผ่านกระแสเปลี่ยนขา $X+$ และ $X-$ ด้วยค่าความนำกระแสตัวที่สอง อีกทั้งค่าความนำกระแสยังสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จากกระแสไปออกภายนอก จึงทำให้มีการนำเอาอุปกรณ์นี้ไปประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรต่าง ๆ มากมาย เช่น วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรกรองความถี่ เป็นต้น

จุดมุ่งหมายของบทความวิจัยนี้ เพื่อสังเคราะห์ วงจรขยายในใหม่ด้วย VDTA ตัวเดียวที่สามารถต่อใช้งานจริงได้ด้วยไอซี LM13700 ที่มีลักษณะเด่นคือ วงจรขยายกระแสใช้อุปกรณ์พัลซีสได้ มาตรฐาน มีเอาต์พุตอัมพิเดนซ์สูง ที่สามารถต่อใช้งานจริงได้ด้วยไอซี สามารถ

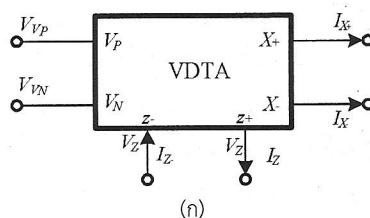
ควบคุมอัตราขยายได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านสื่อสารข้อมูลได้

2. วงจรและหลักการทำงานของวงจร

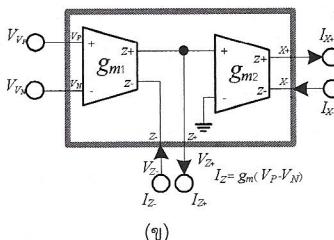
2.1 หลักการทำงานของ VDTA

เนื่องจากวงจรที่นำเสนอมามีอุปกรณ์ VDTA เป็นอุปกรณ์หลักอีกยังใช้อุปกรณ์นี้เพียงตัวเดียว จึงยกล่าวถึง VDTA สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยวงจรที่ 1 มีขาอินพุต 2 ขาคือ V_{VP} และ V_{VN} มีเอาต์พุตคือขา Z และ $X+, X-$ ที่มีอัมพิเดนซ์สูงทุกขา มีคุณลักษณะความสัมพันธ์ของกระแส และแรงดันดังสมการที่ 1

$$\begin{bmatrix} I_Z \\ I_{X+} \\ I_{X-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{m1} & -g_{m1} & 0 \\ 0 & 0 & g_{m2} \\ 0 & 0 & -g_{m2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{VP} \\ V_{VN} \\ V_Z \end{bmatrix} \quad (1)$$



(ก)



(ข)

รูปที่ 1 (ก) สัญลักษณ์และ (ข) วงจรสมมูลของ VDTA

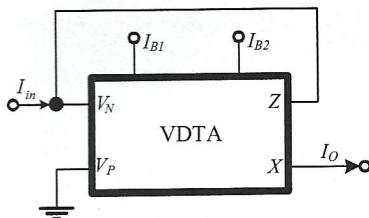
จากโครงสร้างของ VDTA ได้เลือกใช้เป็นทรานซิสเตอร์แบบ bipolar junction transistor (BJT) ดังนั้นค่า g_{m1} และ g_{m2} จะมีค่าของ g_m ดังสมการที่ 2

$$g_m = \frac{I_B}{2V_T} \quad (2)$$

เมื่อ V_T เป็นศักดิ์ความร้อนที่มีค่า 26mV ที่อุณหภูมิห้อง (27°C)

2.2 หลักการออกแบบจรรยาภัยในโหมดกระแส

พิจารณาจะสมมูลของ VDTA ดังแสดงในรูปที่ 1 (ข) และสามารถออกแบบจรรยาภัยในโหมดกระแสได้ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 วงจรขยายโหมดกระแสที่นำเสนอด้วยคุณสมบัติของอุปกรณ์ในสมการที่ 1 จะได้

$$I_Z = g_{m1} (V_{VP} - V_{VN}) \quad (3)$$

และ

$$I_X = g_{m2} V_Z \quad (4)$$

จากรูปที่ 2

$$V_N = V_Z \quad (5)$$

$$I_{in} + I_Z = 0 \quad (5)$$

จะได้

$$I_{in} = -I_Z \quad (6)$$

จากสมการที่ 4 จะได้

$$V_Z = -\frac{I_Z}{g_{m1}} \quad (7)$$

ฉะนั้น เมื่อแทน V_Z ลงในสมการที่ 4 จะได้

$$I_X = \frac{g_{m2}}{g_{m1}} I_{in} \quad (8)$$

เมื่อ $I_X = I_O$ จะได้

$$I_O = \frac{g_{m2}}{g_{m1}} I_{in} \quad (9)$$

อัตราขยายของวงจรหาได้

$$\frac{I_O}{I_{in}} = \frac{g_{m2}}{g_{m1}} \quad (10)$$

$$\text{แทน } g_m = \frac{I_B}{2V_T}$$

สามารถเขียนสมการที่ 10 ใหม่ได้

$$\frac{I_O}{I_{in}} = \frac{I_{B2}}{I_{B1}} \quad (11)$$

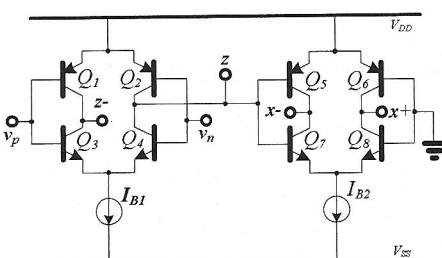
จากสมการที่ 10 และ 11 จะเห็นได้ว่ากระแสเอ้าท์พุตที่ได้จากการสัดส่วนของ I_{B2} และ I_{B1} ที่สามารถปรับอัตราขยายได้ด้วยการปรับกระแส หรืออกล่าวได้ว่าสามารถปรับอัตราขยายได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และอัตราการขยายของวงจรไม่ขึ้นกับอุณหภูมิเนื่องจากไม่มีค่าของ V_T มาเกี่ยวข้องในสมการ

3. ผลการจำลองการทำงาน

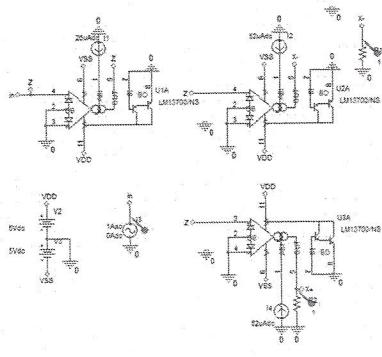
เพื่อเป็นการยืนยันสมรรถนะของวงจรที่นำเสนอดังนี้ได้จำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSpice สำหรับทรานซิสเตอร์ PNP และ NPN ที่ใช้ในการจำลองการทำงานของวงจร ได้ใช้พารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ของทรานซิสเตอร์ PR200N และ NR200N ตามลำดับ ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์อาร์เรย์ ALA400 ของบริษัท AT&T [15] จากรูปที่ 3 แสดงโครงสร้างภายในของ VDTA ซึ่งเชื่อมไปในการจำลองการทำงานนี้กำหนดให้แหล่งจ่ายของวงจร คือ $\pm 1.5V$. และใช้อีซี LM13700 ต่อเส้นแบบวงจร VDTA ได้ดังรูปที่ 4 ใช้อีซีสองตัวเพื่อให้ได้วงจรขยายกระแสแบบสามัญ และกลับสามัญเนื่องจากแหล่งกำเนิดสามัญ และวัสดุสามัญที่มีเป็นแบบแรงดันตั้งนั้น ต้องต่อตัวต้านทาน 100Ω ขนาดกับแหล่งกำเนิดสามัญ และวัสดุสามัญจากนั้นสามารถคำนวณหา I_{in} และ I_O ได้ดังสมการที่ 12 และ 13 กำหนดแรงดันอินพุตเท่ากับ $100mV$ และใช้แหล่งจ่าย $\pm 5V$.

$$I_{in} = \frac{V_{in}}{100} \quad (12)$$

$$I_O = \frac{V_O}{100} \quad (13)$$



รูปที่ 3 โครงสร้างภายในของ VDTA

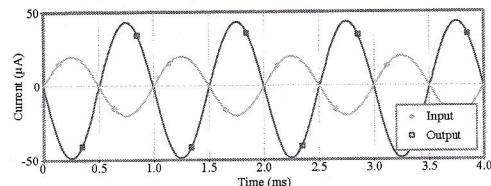


รูปที่ 4 วงจรขยายกระแสตามสัญญาณ และกลับสัญญาณ
ด้วยไอซี LM13700

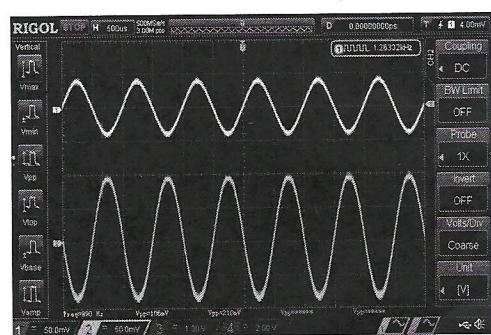
รูปที่ 5 เป็นการจำลองการทำงานของวงจรขยายในโหมดกระแส แสดงในรูปที่ 5 (ก) เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตเป็น I_{sin} ขนาด 20 μ A ที่ความถี่ 1kHz ให้กระแสใบแอลอสที่ $I_{B1}=50\mu$ A และ $I_{B2}=100\mu$ A และเพื่อให้สะดวกในการดูผลจำลองจึงให้ออต์พุตเท็นเป็นค่าคงคลน (กลับสัญญาณ) ดังแสดงในรูปที่ 5 (ข) ผลการทำงานของไอซี LM13700 ที่ต่อเลียนแบบ VDTA ดังรูปที่ 6 แสดง วงจรขยายกระแสด้วยไอซีจริง รูปที่ 7 แสดงให้เห็นการทดลองที่ต่อไอซีเป็นวงจรขยายกระแส และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

ผลการทดลองปรับอัตราการขยายกระแสด้วยการปรับกระแส I_{B2} ดังแสดงในรูปที่ 8(ก) เป็นการจำลองการทำงานด้วยการกำหนดเงื่อนไขคือ ป้อนอินพุตเป็น I_{sin} ขนาด 20 μ A ที่ความถี่ 1kHz และกำหนดให้ $I_{B1}=50\mu$ A และปรับกระแสใบแอลอส $I_{B2}=25\mu$ A, 50 μ A, 100 μ A และ 150 μ A ตามลำดับจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายสัญญาณสามารถควบคุมได้ด้วยการปรับกระแส ใบแอลจากภายนอก หรือที่เรียกวินัยหนึ่งว่าการปรับอัตราการขยายด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นกันเพื่อให้ง่ายในการติดตั้งพาร์เจ็สได้ทำการกลับสัญญาณออต์พุต รูปที่ 8(ข) ผลการทดลองของไอซีกำหนดให้อินพุตเป็นสัญญาณชายน์ขนาด 90 mV ที่ความถี่ 1kHz เช่นกันจากนั้นทำการกำหนดให้ $I_{B1}=631\mu$ A ปรับกระแส $I_{B2}=195\mu$ A, 629 μ A และ 1643 μ A ตามลำดับ ในรูปที่ 9 เป็นการทดสอบผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรขยายกระแส รูปที่ 9(ก) ได้จากการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม PSpice ดัง

แสดงในรูปที่ 9(ข) ได้จากการวัดเอาต์พุตในแต่ละช่วงความถี่ทั้งหมด 45 ค่าจากนั้นทำการเขียนแผนภูมิตัวอย่างบนของความถี่ด้วยโปรแกรม Excel จะเห็นได้ว่างจริงมีผลตอบสนองทางความถี่มากกว่า 1MHz

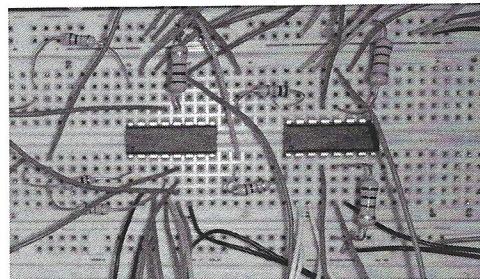


(ก) ผลการจำลองด้วยโปรแกรม



(ข) ผลการทำงานของไอซี

รูปที่ 5 เปรียบเทียบอัตราการขยายอินพุตกับออต์พุต

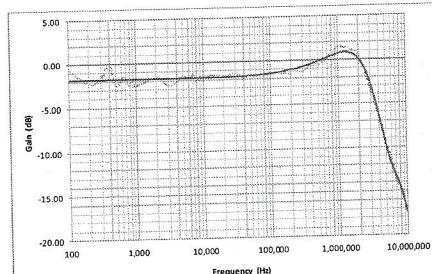


รูปที่ 6 วงจรขยายกระแสต่อเลียนแบบ VDTA ด้วยไอซี

LM13700

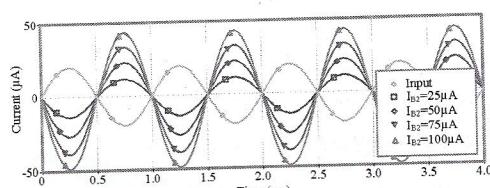


รูปที่ 7 เป็นรูปเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองใช้ไอซี LM13700 เลี้ยงแบบ VDTA เป็นวงจรขยายกระแส

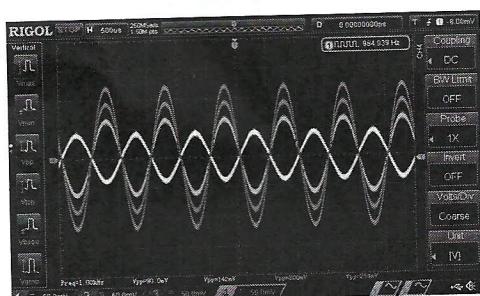


(ข) ผลตอบสนองทางความถี่ของไอซี

รูปที่ 9 ผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรที่นำเสนอด้วย

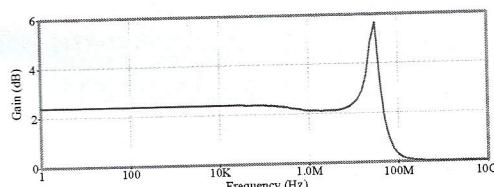


(ก) ผลการจำลองด้วยโปรแกรม

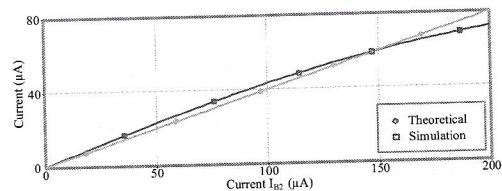


(ก) ผลการทำงานของไอซี

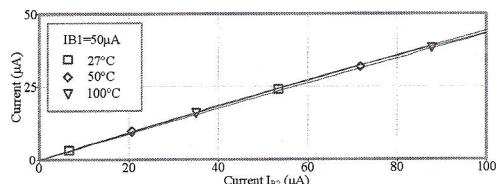
รูปที่ 8 ปรับอัตราการขยายด้วยกระแสไบแอดส์ I_{B2}



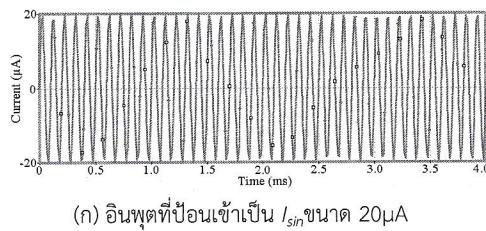
(ก) ผลการจำลองด้วยโปรแกรม



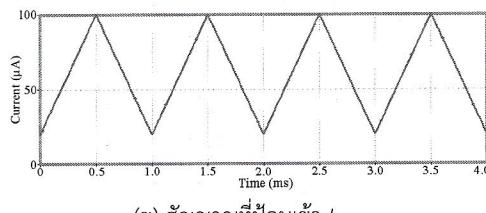
รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการจำลองการทำงานกับค่าที่คำนวณได้



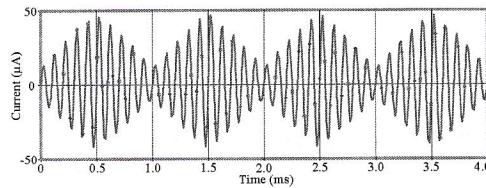
รูปที่ 11 อัตราขยายเมื่อปรับ I_{B2} และอุณหภูมิ $27^\circ C$, $50^\circ C$ และ $100^\circ C$



(ก) อินพุตที่ป้อนเข้าเป็น I_{sin} ขนาด $20\mu A$

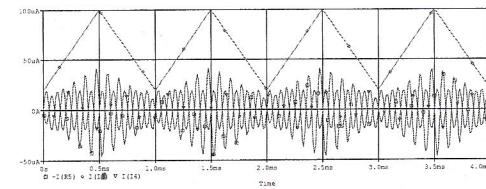


(x) สัญญาณที่ป้อนเข้า I_{B2}



(ค) ผลการจำลองที่ได้จากการที่ป้อนอินพุต

รูปที่ 12 ประยุกต์ใช้งานเป็นวงจรกล้ำสัญญาณแบบ
แอมป์ลิจูด



รูปที่ 13 ผลการประยุกต์เป็นวงจรกล้ำสัญญาณแบบ
แอมป์ลิจูด

4. สรุปผลการทดลอง

บทความวิจัยนี้ได้นำเสนอ การสังเคราะห์ วงจรขยายในโหมดกระแสด้วย VDTA เพียงตัวเดียว ซึ่งมี คุณลักษณะเด่นคือ สามารถปรับอัตราขยายได้ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกระแสใบແօສ I_{B1} และ I_{B2} ใช้เพียง อุปกรณ์ VDTA เพียงตัวเดียว ปราศจากอุปกรณ์พัสดุซึ่งมา ต่อร่วม ผลการจำลองการทำงานแสดงถึงทางทฤษฎีมี อัตราสั้นเปลืองพลังงาน $0.58mW$ ที่เหลือจ่าย $\pm 1.5V$ ทั้งนี้สามารถต่อใช้งานจริงได้ด้วยไอซีมีผลการทำงาน เป็นไปตามทฤษฎีและผลการจำลองการทำงาน มีการ ตอบสนองความถี่มากกว่า $1MHz$ นอกจากจะเป็น วงจรขยายสัญญาณในโหมดกระแสทั้งแบบตามสัญญาณ และกลับสัญญาณยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงจรกล้ำ สัญญาณแบบแอมป์ลิจูดได้ด้วย

5. เอกสารอ้างอิง

- [1] G. Palmisano, G. Palumbo, S. Pennisi, "CMOS Current Amplifiers," Kluwer Academic Publishers, 1999.
- [2] K. Kaewdang, W. Surakampontom, and N. Fujii, "A design of controllable gain class B push-pull current amplifier," *IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, 2005. ISCAS 2005, vol. 2, pp.1577 - 1580, 2005.
- [3] C. Toumazou, F. J. Lidger, and D. G. Haigh, "Analogue IC design: the current-mode approach," Peregrinus, London, 1990.
- [4] C. S. Hilas, and T. N. Laopoulos, "Circuit design: a study on voltage-mode to current-mode conversion technique," *Proceedings of 8th Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON '96*, Bari, Italy, May 13-16, pp. 1309-1312, 1996.
- [5] S.-H. Yang, K.-H. Kim, Y.-H. Kim, Y. You, and K.-R. Cho, "A novel CMOS operational transconductance amplifier based on a mobility compensation technique," *IEEE*

- Transactions on Circuits and system—II: Express Briefs*, vol. 52, no. 1, pp. 37–41, 2005.
- [6] S. Minae, G. Topcu, and O. Cicekoğlu, “Active only integrator and differentiator with tunable time constants,” *INT. J. Electronics*, vol. 90, no. 9, pp. 581–588, 2003.
- [7] W. Surakampontorn, V. Riewruja, K. Kumwachara, C. Surawatpunya, and K. Anuntahirunrat, “Temperature-insensitive voltage-to-current converter and its applications,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 48, no. 6, pp. 1270-1277, 1999.
- [8] TexasInstruments,LM13700, Copyright@2013, Texas Instruments Incorporated.
- [9] วิทยา ศรีกุล, สมชาย ศรีสกุลเตี้ย และมนตรี ศิริปรัชญาณันท์, “การสังเคราะห์ตัวควบคุม PI, PD และ PID โดยใช้ช่วงจรสายพานกระแส” ประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4, หนองคาย, 2555.
- [10] สมชาย ศรีสกุลเตี้ย และมนตรี ศิริปรัชญาณันท์, “การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบสัดส่วนร่วมกับปริพันธ์ และอนุพันธ์ในโหมดกระแส โดยใช้ช่วงจรสายพานกระแสควบคุมด้วยกระแส” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ, หน้า 63-68, 2553.
- [11] สมชาย ศรีสกุลเตี้ย, ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และมนตรี ศิริปรัชญาณันท์, “การสังเคราะห์ตัวควบคุม ในโหมดกระแส PI, PD และ PID ด้วยวงจรขยายป้อนกลับกระแส” ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพ, หน้า 28-35, 2553.
- [12] D. Biolek, “CDTA building for current-mode analog signal processing”, Proceeding of European conference theory and design, ECC TD03, 2003.
- [13] S. Srisakultiew, S. Lawanpisut, M. Siripruchyanun, “A synthesis of low component count for current-mode PI, PD and PID controller employing CCTA”, 37th International conference on telecommunication and signal proceeding (TSP-2014), Germany, pp. 409-413, 2014.
- [14] V. BIOLKOVA, Z. KOLKA, D. BIOLEK, “Fully balanced voltage differencing buffered amplifier and its applications.” In 52nd IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems MWSCAS'09. Cancun (Mexico), p.45 – 48, 2009.
- [15] D.R. Frey, “Log-Domain Filtering: An Approach to Current-Mode Filtering”, IEE Proc. Circuit Devices Syst. Vol.140: pp. 406-410, 1993.